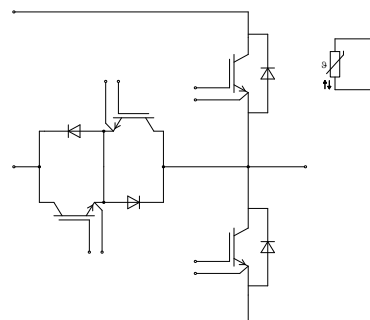
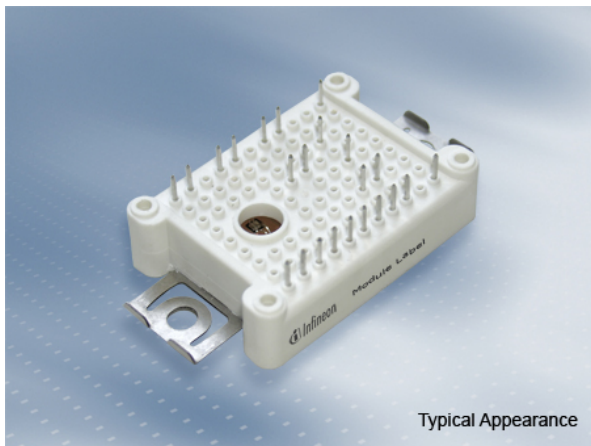


暫定データ / Preliminary Data



$V_{CES} = 1200V$

$I_{C\ nom} = 25A / I_{CRM} = 50A$

一般応用

- 3レベル アプリケーション
- ソーラーアプリケーション

Typical Applications

- 3-Level-Applications
- Solar Applications

電気的特性

- 低インダクタンスデザイン
- 低スイッチング損失
- 低 V_{CEsat} 飽和電圧

Electrical Features

- Low inductive design
- Low Switching Losses
- Low V_{CEsat}

機械的特性

- 低熱インピーダンスの Al_2O_3 DCB
- コンパクトデザイン
- PressFIT 接合 技術
- 固定用クランプによる強固なマウンティング

Mechanical Features

- Al_2O_3 Substrate with Low Thermal Resistance
- Compact design
- PressFIT Contact Technology
- Rugged mounting due to integrated mounting clamps

Module Label Code

Barcode Code 128



DMX - Code



Content of the Code

Content of the Code	Digit
Module Serial Number	1 - 5
Module Material Number	6 - 11
Production Order Number	12 - 19
Datecode (Production Year)	20 - 21
Datecode (Production Week)	22 - 23

prepared by: CM

date of publication: 2013-11-25

approved by: MB

revision: 2.0

UL approved (E83335)

暫定データ
Preliminary Data

IGBT, T1 / T4 / IGBT, T1 / T4
最大定格 / Maximum Rated Values

コレクタ・エミッタ間電圧 Collector-emitter voltage	$T_{vj} = 25^{\circ}\text{C}$	V_{CES}	1200	V
連続DCコレクタ電流 Continuous DC collector current	$T_C = 100^{\circ}\text{C}, T_{vj\max} = 175^{\circ}\text{C}$ $T_C = 25^{\circ}\text{C}, T_{vj\max} = 175^{\circ}\text{C}$	$I_{C\text{nom}}$ I_C	25 45	A A
繰り返しピークコレクタ電流 Repetitive peak collector current	$t_P = 1\text{ ms}$	I_{CRM}	50	A
トータル損失 Total power dissipation	$T_C = 25^{\circ}\text{C}, T_{vj\max} = 175^{\circ}\text{C}$	P_{tot}	215	W
ゲート・エミッタ間ピーク電圧 Gate-emitter peak voltage		V_{GES}	+/-20	V

電気的特性 / Characteristic Values

			min.	typ.	max.	
コレクタ・エミッタ間飽和電圧 Collector-emitter saturation voltage	$I_C = 25\text{ A}, V_{GE} = 15\text{ V}$ $I_C = 25\text{ A}, V_{GE} = 15\text{ V}$ $I_C = 25\text{ A}, V_{GE} = 15\text{ V}$	$T_{vj} = 25^{\circ}\text{C}$ $T_{vj} = 125^{\circ}\text{C}$ $T_{vj} = 150^{\circ}\text{C}$	$V_{CE\text{sat}}$	1,85 2,15 2,25	2,25	V V V
ゲート・エミッタ間しきい値電圧 Gate threshold voltage	$I_C = 0,80\text{ mA}, V_{CE} = V_{GE}, T_{vj} = 25^{\circ}\text{C}$		V_{GEth}	5,0	5,8	6,5 V
ゲート電荷量 Gate charge	$V_{GE} = -15\text{ V} \dots +15\text{ V}$		Q_G	0,20		μC
内蔵ゲート抵抗 Internal gate resistor	$T_{vj} = 25^{\circ}\text{C}$		R_{Gint}	0,0		Ω
入力容量 Input capacitance	$f = 1\text{ MHz}, T_{vj} = 25^{\circ}\text{C}, V_{CE} = 25\text{ V}, V_{GE} = 0\text{ V}$		C_{ies}	1,45		nF
帰還容量 Reverse transfer capacitance	$f = 1\text{ MHz}, T_{vj} = 25^{\circ}\text{C}, V_{CE} = 25\text{ V}, V_{GE} = 0\text{ V}$		C_{res}	0,05		nF
コレクタ・エミッタ間遮断電流 Collector-emitter cut-off current	$V_{CE} = 1200\text{ V}, V_{GE} = 0\text{ V}, T_{vj} = 25^{\circ}\text{C}$		I_{CES}		1,0	mA
ゲート・エミッタ間漏れ電流 Gate-emitter leakage current	$V_{CE} = 0\text{ V}, V_{GE} = 20\text{ V}, T_{vj} = 25^{\circ}\text{C}$		I_{GES}		100	nA
ターンオン遅れ時間 (誘導負荷) Turn-on delay time, inductive load	$I_C = 25\text{ A}, V_{CE} = 350\text{ V}$ $V_{GE} = 15\text{ V}$ $R_{Gon} = 10\ \Omega$	$T_{vj} = 25^{\circ}\text{C}$ $T_{vj} = 125^{\circ}\text{C}$ $T_{vj} = 150^{\circ}\text{C}$	t_{don}	0,035 0,035 0,035		μs μs μs
ターンオン上昇時間 (誘導負荷) Rise time, inductive load	$I_C = 25\text{ A}, V_{CE} = 350\text{ V}$ $V_{GE} = 15\text{ V}$ $R_{Gon} = 10\ \Omega$	$T_{vj} = 25^{\circ}\text{C}$ $T_{vj} = 125^{\circ}\text{C}$ $T_{vj} = 150^{\circ}\text{C}$	t_r	0,014 0,018 0,019		μs μs μs
ターンオフ遅れ時間 (誘導負荷) Turn-off delay time, inductive load	$I_C = 25\text{ A}, V_{CE} = 350\text{ V}$ $V_{GE} = 15\text{ V}$ $R_{Goff} = 10\ \Omega$	$T_{vj} = 25^{\circ}\text{C}$ $T_{vj} = 125^{\circ}\text{C}$ $T_{vj} = 150^{\circ}\text{C}$	t_{doff}	0,215 0,275 0,285		μs μs μs
ターンオフ下降時間 (誘導負荷) Fall time, inductive load	$I_C = 25\text{ A}, V_{CE} = 350\text{ V}$ $V_{GE} = 15\text{ V}$ $R_{Goff} = 10\ \Omega$	$T_{vj} = 25^{\circ}\text{C}$ $T_{vj} = 125^{\circ}\text{C}$ $T_{vj} = 150^{\circ}\text{C}$	t_f	0,056 0,08 0,09		μs μs μs
ターンオンスイッチング損失 Turn-on energy loss per pulse	$I_C = 25\text{ A}, V_{CE} = 350\text{ V}, L_S = 40\text{ nH}$ $V_{GE} = 15\text{ V}, di/dt = 1600\text{ A}/\mu\text{s} (T_{vj} = 150^{\circ}\text{C})$ $R_{Gon} = 10\ \Omega$	$T_{vj} = 25^{\circ}\text{C}$ $T_{vj} = 125^{\circ}\text{C}$ $T_{vj} = 150^{\circ}\text{C}$	E_{on}	0,30 0,50 0,56		mJ mJ mJ
ターンオフスイッチング損失 Turn-off energy loss per pulse	$I_C = 25\text{ A}, V_{CE} = 350\text{ V}, L_S = 40\text{ nH}$ $V_{GE} = 15\text{ V}, du/dt = 2500\text{ V}/\mu\text{s} (T_{vj} = 150^{\circ}\text{C})$ $R_{Goff} = 10\ \Omega$	$T_{vj} = 25^{\circ}\text{C}$ $T_{vj} = 125^{\circ}\text{C}$ $T_{vj} = 150^{\circ}\text{C}$	E_{off}	1,00 1,40 1,50		mJ mJ mJ
短絡電流 SC data	$V_{GE} \leq 15\text{ V}, V_{CC} = 800\text{ V}$ $V_{CEmax} = V_{CES} - L_{SCE} \cdot di/dt$ $t_P \leq 10\ \mu\text{s}, T_{vj} = 150^{\circ}\text{C}$		I_{SC}	90		A
ジャンクション・ケース間熱抵抗 Thermal resistance, junction to case	IGBT部 (1 素子当り) / per IGBT		R_{thJC}	0,65	0,70	K/W
ケース・ヒートシンク間熱抵抗 Thermal resistance, case to heatsink	IGBT部 (1 素子当り) / per IGBT $\lambda_{\text{Paste}} = 1\text{ W}/(\text{m}\cdot\text{K})$ / $\lambda_{\text{grease}} = 1\text{ W}/(\text{m}\cdot\text{K})$		R_{thCH}	0,70		K/W
動作温度 Temperature under switching conditions			$T_{vj\text{op}}$	-40	150	$^{\circ}\text{C}$

prepared by: CM

date of publication: 2013-11-25

approved by: MB

revision: 2.0

暫定データ
Preliminary Data

ダイオード, D2 / D3 / Diode, D2 / D3

最大定格 / Maximum Rated Values

ピーク繰返し逆電圧 Repetitive peak reverse voltage	$T_{vj} = 25^{\circ}\text{C}$	V_{RRM}	650	V
連続DC電流 Continuous DC forward current		I_F	25	A
ピーク繰返し順電流 Repetitive peak forward current	$t_P = 1 \text{ ms}$	I_{FRM}	50	A
電流二乗時間積 I^2t - value	$V_R = 0 \text{ V}, t_P = 10 \text{ ms}, T_{vj} = 125^{\circ}\text{C}$ $V_R = 0 \text{ V}, t_P = 10 \text{ ms}, T_{vj} = 150^{\circ}\text{C}$	I^2t	130 115	A^2s A^2s

電気的特性 / Characteristic Values

				min.	typ.	max.	
順電圧 Forward voltage	$I_F = 25 \text{ A}, V_{GE} = 0 \text{ V}$ $I_F = 25 \text{ A}, V_{GE} = 0 \text{ V}$ $I_F = 25 \text{ A}, V_{GE} = 0 \text{ V}$	$T_{vj} = 25^{\circ}\text{C}$ $T_{vj} = 125^{\circ}\text{C}$ $T_{vj} = 150^{\circ}\text{C}$	V_F		1,35 1,30 1,25	t.b.d.	V V V
ピーク逆回復電流 Peak reverse recovery current	$I_F = 25 \text{ A}, -di_F/dt = 1600 \text{ A}/\mu\text{s} (T_{vj}=150^{\circ}\text{C})$ $V_R = 350 \text{ V}$	$T_{vj} = 25^{\circ}\text{C}$ $T_{vj} = 125^{\circ}\text{C}$ $T_{vj} = 150^{\circ}\text{C}$	I_{RM}		24,0 28,0 30,0		A A A
逆回復電荷量 Recovered charge	$I_F = 25 \text{ A}, -di_F/dt = 1600 \text{ A}/\mu\text{s} (T_{vj}=150^{\circ}\text{C})$ $V_R = 350 \text{ V}$	$T_{vj} = 25^{\circ}\text{C}$ $T_{vj} = 125^{\circ}\text{C}$ $T_{vj} = 150^{\circ}\text{C}$	Q_r		1,20 1,60 1,65		μC μC μC
逆回復損失 Reverse recovery energy	$I_F = 25 \text{ A}, -di_F/dt = 1600 \text{ A}/\mu\text{s} (T_{vj}=150^{\circ}\text{C})$ $V_R = 350 \text{ V}$	$T_{vj} = 25^{\circ}\text{C}$ $T_{vj} = 125^{\circ}\text{C}$ $T_{vj} = 150^{\circ}\text{C}$	E_{rec}		0,22 0,32 0,39		mJ mJ mJ
ジャンクション・ケース間熱抵抗 Thermal resistance, junction to case	/Diode (1 素子当り) / per diode		R_{thJC}		1,10	1,20	K/W
ケース・ヒートシンク間熱抵抗 Thermal resistance, case to heatsink	/Diode (1 素子当り) / per diode $\lambda_{Paste} = 1 \text{ W}/(\text{m}\cdot\text{K})$ / $\lambda_{grease} = 1 \text{ W}/(\text{m}\cdot\text{K})$		R_{thCH}		0,75		K/W
動作温度 Temperature under switching conditions			$T_{vj op}$	-40		150	$^{\circ}\text{C}$

暫定データ
Preliminary Data

IGBT, T2 / T3 / IGBT, T2 / T3
最大定格 / Maximum Rated Values

コレクタ・エミッタ間電圧 Collector-emitter voltage	$T_{vj} = 25^{\circ}\text{C}$	V_{CES}	650	V
連続DCコレクタ電流 Continuous DC collector current	$T_C = 80^{\circ}\text{C}, T_{vj\max} = 175^{\circ}\text{C}$ $T_C = 25^{\circ}\text{C}, T_{vj\max} = 175^{\circ}\text{C}$	$I_{C\text{ nom}}$ I_C	30 45	A A
繰り返しピークコレクタ電流 Repetitive peak collector current	$t_P = 1\text{ ms}$	I_{CRM}	60	A
トータル損失 Total power dissipation	$T_C = 25^{\circ}\text{C}, T_{vj\max} = 175^{\circ}\text{C}$	P_{tot}	150	W
ゲート・エミッタ間ピーク電圧 Gate-emitter peak voltage		V_{GES}	+/-20	V

電気的特性 / Characteristic Values

			min.	typ.	max.	
コレクタ・エミッタ間飽和電圧 Collector-emitter saturation voltage	$I_C = 30\text{ A}, V_{GE} = 15\text{ V}$ $I_C = 30\text{ A}, V_{GE} = 15\text{ V}$ $I_C = 30\text{ A}, V_{GE} = 15\text{ V}$	$T_{vj} = 25^{\circ}\text{C}$ $T_{vj} = 125^{\circ}\text{C}$ $T_{vj} = 150^{\circ}\text{C}$	$V_{CE\text{ sat}}$	1,55 1,70 1,80	2,00	V V V
ゲート・エミッタ間しきい値電圧 Gate threshold voltage	$I_C = 0,30\text{ mA}, V_{CE} = V_{GE}, T_{vj} = 25^{\circ}\text{C}$		V_{GEth}	4,9	5,8	6,5 V
ゲート電荷量 Gate charge	$V_{GE} = -15\text{ V} \dots +15\text{ V}$		Q_G	0,30		μC
内蔵ゲート抵抗 Internal gate resistor	$T_{vj} = 25^{\circ}\text{C}$		R_{Gint}	0,0		Ω
入力容量 Input capacitance	$f = 1\text{ MHz}, T_{vj} = 25^{\circ}\text{C}, V_{CE} = 25\text{ V}, V_{GE} = 0\text{ V}$		C_{ies}	1,65		nF
帰還容量 Reverse transfer capacitance	$f = 1\text{ MHz}, T_{vj} = 25^{\circ}\text{C}, V_{CE} = 25\text{ V}, V_{GE} = 0\text{ V}$		C_{res}	0,051		nF
コレクタ・エミッタ間遮断電流 Collector-emitter cut-off current	$V_{CE} = 650\text{ V}, V_{GE} = 0\text{ V}, T_{vj} = 25^{\circ}\text{C}$		I_{CES}		1,0	mA
ゲート・エミッタ間漏れ電流 Gate-emitter leakage current	$V_{CE} = 0\text{ V}, V_{GE} = 20\text{ V}, T_{vj} = 25^{\circ}\text{C}$		I_{GES}		100	nA
ターンオン遅れ時間 (誘導負荷) Turn-on delay time, inductive load	$I_C = 30\text{ A}, V_{CE} = 350\text{ V}$ $V_{GE} = 15\text{ V}$ $R_{Gon} = 10\text{ }\Omega$	$T_{vj} = 25^{\circ}\text{C}$ $T_{vj} = 125^{\circ}\text{C}$ $T_{vj} = 150^{\circ}\text{C}$	$t_{d\text{ on}}$	0,028 0,028 0,028		μs μs μs
ターンオン上昇時間 (誘導負荷) Rise time, inductive load	$I_C = 30\text{ A}, V_{CE} = 350\text{ V}$ $V_{GE} = 15\text{ V}$ $R_{Gon} = 10\text{ }\Omega$	$T_{vj} = 25^{\circ}\text{C}$ $T_{vj} = 125^{\circ}\text{C}$ $T_{vj} = 150^{\circ}\text{C}$	t_r	0,01 0,013 0,014		μs μs μs
ターンオフ遅れ時間 (誘導負荷) Turn-off delay time, inductive load	$I_C = 30\text{ A}, V_{CE} = 350\text{ V}$ $V_{GE} = 15\text{ V}$ $R_{Goff} = 10\text{ }\Omega$	$T_{vj} = 25^{\circ}\text{C}$ $T_{vj} = 125^{\circ}\text{C}$ $T_{vj} = 150^{\circ}\text{C}$	$t_{d\text{ off}}$	0,22 0,235 0,24		μs μs μs
ターンオフ下降時間 (誘導負荷) Fall time, inductive load	$I_C = 30\text{ A}, V_{CE} = 350\text{ V}$ $V_{GE} = 15\text{ V}$ $R_{Goff} = 10\text{ }\Omega$	$T_{vj} = 25^{\circ}\text{C}$ $T_{vj} = 125^{\circ}\text{C}$ $T_{vj} = 150^{\circ}\text{C}$	t_f	0,055 0,067 0,07		μs μs μs
ターンオンスイッチング損失 Turn-on energy loss per pulse	$I_C = 30\text{ A}, V_{CE} = 350\text{ V}, L_S = 40\text{ nH}$ $V_{GE} = 15\text{ V}, di/dt = 2200\text{ A}/\mu\text{s} (T_{vj} = 150^{\circ}\text{C})$ $R_{Gon} = 10\text{ }\Omega$	$T_{vj} = 25^{\circ}\text{C}$ $T_{vj} = 125^{\circ}\text{C}$ $T_{vj} = 150^{\circ}\text{C}$	E_{on}	0,47 0,63 0,70		mJ mJ mJ
ターンオフスイッチング損失 Turn-off energy loss per pulse	$I_C = 30\text{ A}, V_{CE} = 350\text{ V}, L_S = 40\text{ nH}$ $V_{GE} = 15\text{ V}, du/dt = 4000\text{ V}/\mu\text{s} (T_{vj} = 150^{\circ}\text{C})$ $R_{Goff} = 10\text{ }\Omega$	$T_{vj} = 25^{\circ}\text{C}$ $T_{vj} = 125^{\circ}\text{C}$ $T_{vj} = 150^{\circ}\text{C}$	E_{off}	0,82 1,00 1,10		mJ mJ mJ
短絡電流 SC data	$V_{GE} \leq 15\text{ V}, V_{CC} = 360\text{ V}$ $V_{CE\text{ max}} = V_{CES} - L_{SCE} \cdot di/dt$	$t_P \leq 8\text{ }\mu\text{s}, T_{vj} = 25^{\circ}\text{C}$ $t_P \leq 6\text{ }\mu\text{s}, T_{vj} = 150^{\circ}\text{C}$	I_{SC}	210 150		A A
ジャンクション・ケース間熱抵抗 Thermal resistance, junction to case	IGBT部 (1素子当り) / per IGBT		R_{thJC}	0,90	1,00	K/W
ケース・ヒートシンク間熱抵抗 Thermal resistance, case to heatsink	IGBT部 (1素子当り) / per IGBT $\lambda_{\text{Paste}} = 1\text{ W}/(\text{m}\cdot\text{K})$ / $\lambda_{\text{grease}} = 1\text{ W}/(\text{m}\cdot\text{K})$		R_{thCH}	0,85		K/W
動作温度 Temperature under switching conditions			$T_{vj\text{ op}}$	-40	150	$^{\circ}\text{C}$

prepared by: CM

date of publication: 2013-11-25

approved by: MB

revision: 2.0

暫定データ
Preliminary Data

ダイオード, D1 / D4 / Diode, D1 / D4

最大定格 / Maximum Rated Values

ピーク繰返し逆電圧 Repetitive peak reverse voltage	$T_{vj} = 25^{\circ}\text{C}$	V_{RRM}	1200	V
連続DC電流 Continuous DC forward current		I_F	25	A
ピーク繰返し順電流 Repetitive peak forward current	$t_P = 1 \text{ ms}$	I_{FRM}	50	A
電流二乗時間積 I^2t - value	$V_R = 0 \text{ V}, t_P = 10 \text{ ms}, T_{vj} = 125^{\circ}\text{C}$ $V_R = 0 \text{ V}, t_P = 10 \text{ ms}, T_{vj} = 150^{\circ}\text{C}$	I^2t	90,0 75,0	A^2s A^2s

電気的特性 / Characteristic Values

			min.	typ.	max.	
順電圧 Forward voltage	$I_F = 25 \text{ A}, V_{GE} = 0 \text{ V}$ $I_F = 25 \text{ A}, V_{GE} = 0 \text{ V}$ $I_F = 25 \text{ A}, V_{GE} = 0 \text{ V}$	$T_{vj} = 25^{\circ}\text{C}$ $T_{vj} = 125^{\circ}\text{C}$ $T_{vj} = 150^{\circ}\text{C}$	V_F	1,75 1,75 1,75	2,25	V V V
ピーク逆回復電流 Peak reverse recovery current	$I_F = 25 \text{ A}, -di_F/dt = 1850 \text{ A}/\mu\text{s} (T_{vj}=150^{\circ}\text{C})$ $V_R = 350 \text{ V}$ $V_{GE} = -15 \text{ V}$	$T_{vj} = 25^{\circ}\text{C}$ $T_{vj} = 125^{\circ}\text{C}$ $T_{vj} = 150^{\circ}\text{C}$	I_{RM}	66,0 70,0 70,0		A A A
逆回復電荷量 Recovered charge	$I_F = 25 \text{ A}, -di_F/dt = 1850 \text{ A}/\mu\text{s} (T_{vj}=150^{\circ}\text{C})$ $V_R = 350 \text{ V}$ $V_{GE} = -15 \text{ V}$	$T_{vj} = 25^{\circ}\text{C}$ $T_{vj} = 125^{\circ}\text{C}$ $T_{vj} = 150^{\circ}\text{C}$	Q_r	1,75 3,50 4,00		μC μC μC
逆回復損失 Reverse recovery energy	$I_F = 25 \text{ A}, -di_F/dt = 1850 \text{ A}/\mu\text{s} (T_{vj}=150^{\circ}\text{C})$ $V_R = 350 \text{ V}$ $V_{GE} = -15 \text{ V}$	$T_{vj} = 25^{\circ}\text{C}$ $T_{vj} = 125^{\circ}\text{C}$ $T_{vj} = 150^{\circ}\text{C}$	E_{rec}	0,63 1,10 1,15		mJ mJ mJ
ジャンクション・ケース間熱抵抗 Thermal resistance, junction to case	/Diode (1 素子当り) / per diode		R_{thJC}	0,95	1,05	K/W
ケース・ヒートシンク間熱抵抗 Thermal resistance, case to heatsink	/Diode (1 素子当り) / per diode $\lambda_{Paste} = 1 \text{ W}/(\text{m}\cdot\text{K})$ / $\lambda_{grease} = 1 \text{ W}/(\text{m}\cdot\text{K})$		R_{thCH}	0,85		K/W
動作温度 Temperature under switching conditions			$T_{vj op}$	-40	150	$^{\circ}\text{C}$

NTC-サーミスタ / NTC-Thermistor

電気的特性 / Characteristic Values

			min.	typ.	max.	
定格抵抗値 Rated resistance	$T_C = 25^{\circ}\text{C}$	R_{25}		5,00		$\text{k}\Omega$
R100の偏差 Deviation of R100	$T_C = 100^{\circ}\text{C}, R_{100} = 493 \Omega$	$\Delta R/R$	-5		5	%
損失 Power dissipation	$T_C = 25^{\circ}\text{C}$	P_{25}			20,0	mW
B-定数 B-value	$R_2 = R_{25} \exp [B_{25/50}(1/T_2 - 1/(298,15 \text{ K}))]$	$B_{25/50}$		3375		K
B-定数 B-value	$R_2 = R_{25} \exp [B_{25/80}(1/T_2 - 1/(298,15 \text{ K}))]$	$B_{25/80}$		3411		K
B-定数 B-value	$R_2 = R_{25} \exp [B_{25/100}(1/T_2 - 1/(298,15 \text{ K}))]$	$B_{25/100}$		3433		K

適切なアプリケーションノートによる仕様

Specification according to the valid application note.

prepared by: CM	date of publication: 2013-11-25
approved by: MB	revision: 2.0

暫定データ
Preliminary Data

モジュール / Module

絶縁耐圧 Isolation test voltage	RMS, f = 50 Hz, t = 1 min.	V _{ISOL}	2,5	kV
内部絶縁 Internal isolation	基礎絶縁 (クラス1, IEC 61140) basic insulation (class 1, IEC 61140)		Al ₂ O ₃	
沿面距離 Creepage distance	連絡方法 - ヒートシンク / terminal to heatsink 連絡方法 - 連絡方法 / terminal to terminal		11,5 6,3	mm
空間距離 Clearance	連絡方法 - ヒートシンク / terminal to heatsink 連絡方法 - 連絡方法 / terminal to terminal		10,0 5,0	mm
相対トラッキング指数 Comperative tracking index		CTI	> 200	
内部インダクタンス Stray inductance module		L _{sCE}	min. 30	typ. max. nH
パワーターミナル・チップ間抵抗 Module lead resistance, terminals - chip	T _c = 25°C, /スイッチ / per switch	R _{CC'+EE'} R _{AA'+CC'}	5,00 6,00	mΩ
保存温度 Storage temperature		T _{stg}	-40	125 °C
Anpresskraft für mech. Bef. pro Feder mounting force per clamp		F	40	- 80 N
質量 Weight		G	24	g

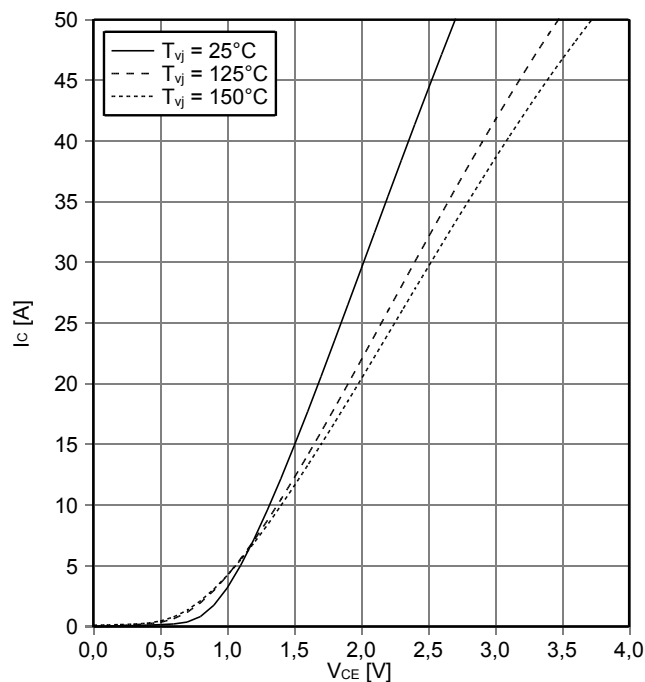
Der Strom im Dauerbetrieb ist auf 25A effektiv pro Anschlusspin begrenzt.
The current under continuous operation is limited to 25A rms per connector pin.

prepared by: CM	date of publication: 2013-11-25
approved by: MB	revision: 2.0

暫定データ
Preliminary Data

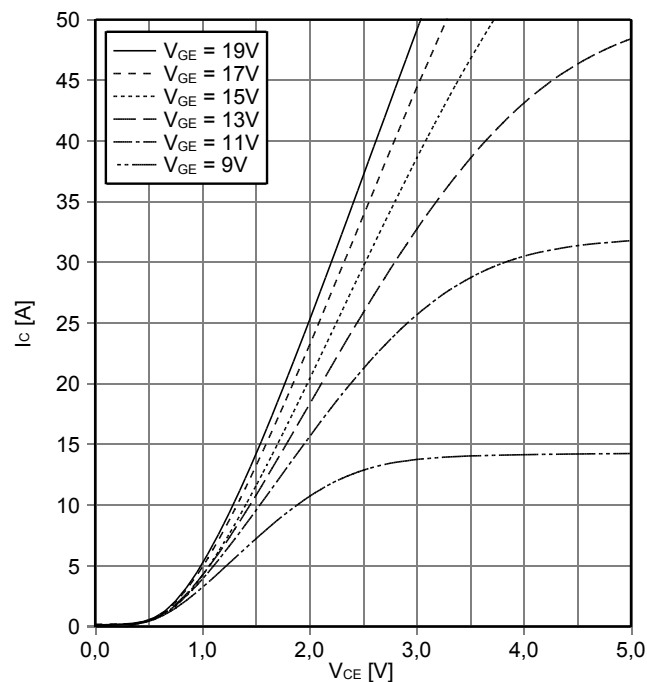
出力特性 IGBT, T1 / T4 (Typical)
output characteristic IGBT, T1 / T4 (typical)

$I_C = f(V_{CE})$
 $V_{GE} = 15 \text{ V}$



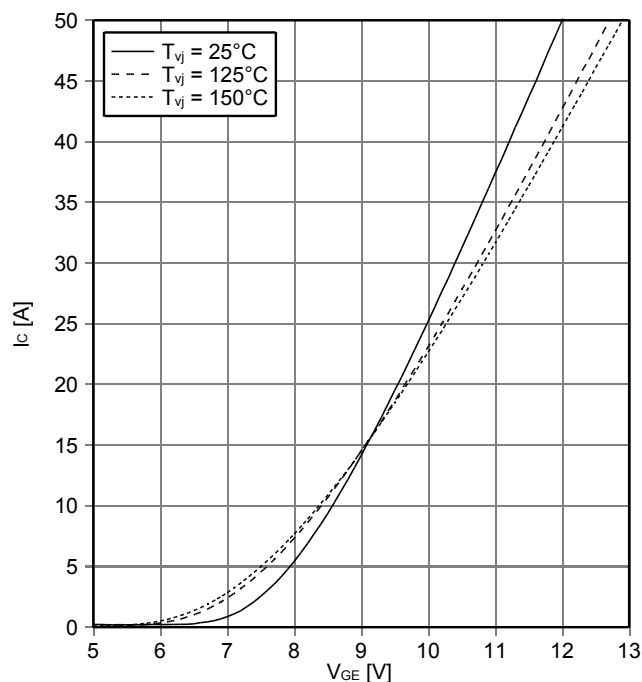
出力特性 IGBT, T1 / T4 (Typical)
output characteristic IGBT, T1 / T4 (typical)

$I_C = f(V_{CE})$
 $T_{vj} = 150^\circ\text{C}$



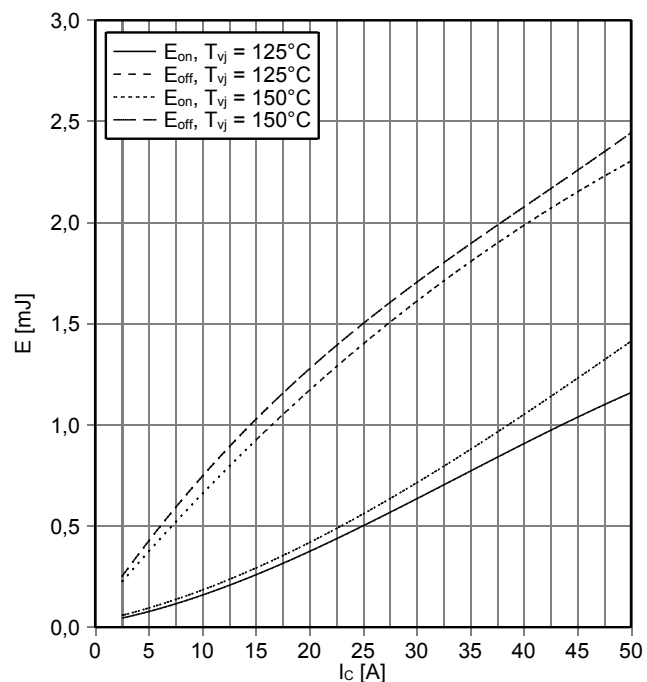
伝達特性 IGBT, T1 / T4 (Typical)
transfer characteristic IGBT, T1 / T4 (typical)

$I_C = f(V_{GE})$
 $V_{CE} = 20 \text{ V}$



スイッチング損失 IGBT, T1 / T4 (Typical)
switching losses IGBT, T1 / T4 (typical)

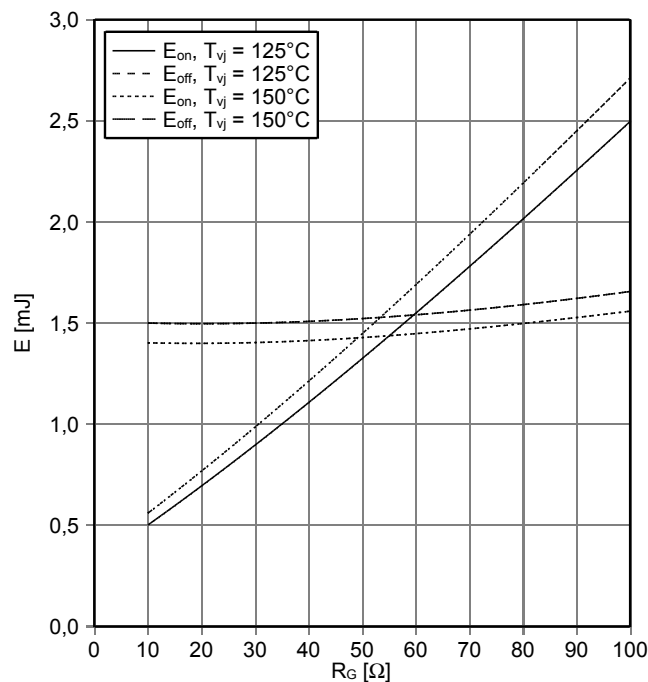
$E_{on} = f(I_C)$, $E_{off} = f(I_C)$
 $V_{GE} = \pm 15 \text{ V}$, $R_{Gon} = 10 \text{ } \Omega$, $R_{Goff} = 10 \text{ } \Omega$, $V_{CE} = 350 \text{ V}$



暫定データ
Preliminary Data

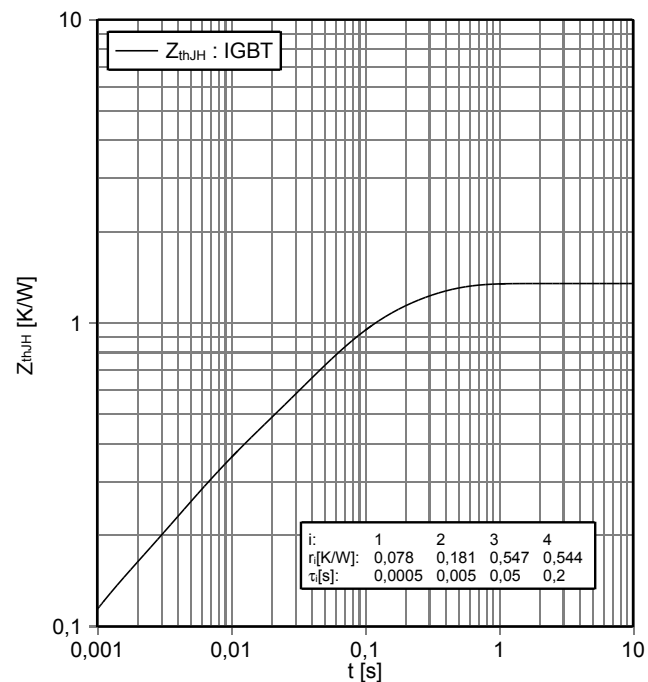
スイッチング損失 IGBT, T1 / T4 (Typical)
switching losses IGBT, T1 / T4 (typical)

$E_{on} = f(R_G)$, $E_{off} = f(R_G)$
 $V_{GE} = \pm 15 \text{ V}$, $I_C = 25 \text{ A}$, $V_{CE} = 350 \text{ V}$



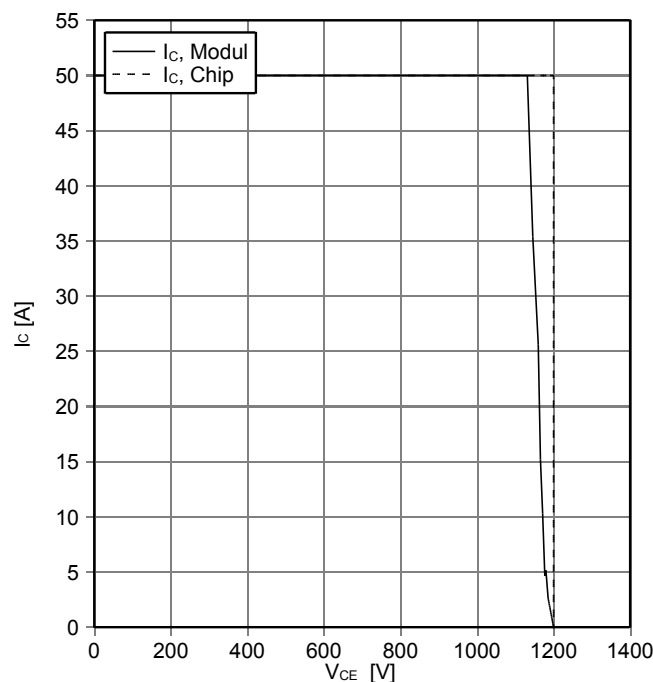
過渡熱インピーダンス IGBT, T1 / T4
transient thermal impedance IGBT, T1 / T4

$Z_{thJH} = f(t)$



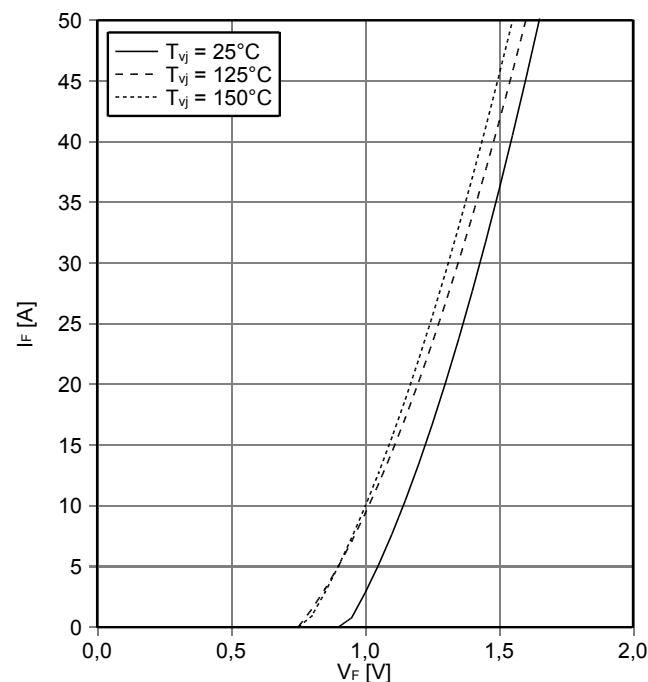
逆バイアス安全動作領域 IGBT, T1 / T4 (RBSOA)
reverse bias safe operating area IGBT, T1 / T4 (RBSOA)

$I_C = f(V_{CE})$
 $V_{GE} = \pm 15 \text{ V}$, $R_{Goff} = 10 \Omega$, $T_{vj} = 150^\circ\text{C}$



順電圧特性 ダイオード, D2 / D3 (typical)
forward characteristic of Diode, D2 / D3 (typical)

$I_F = f(V_F)$



prepared by: CM

date of publication: 2013-11-25

approved by: MB

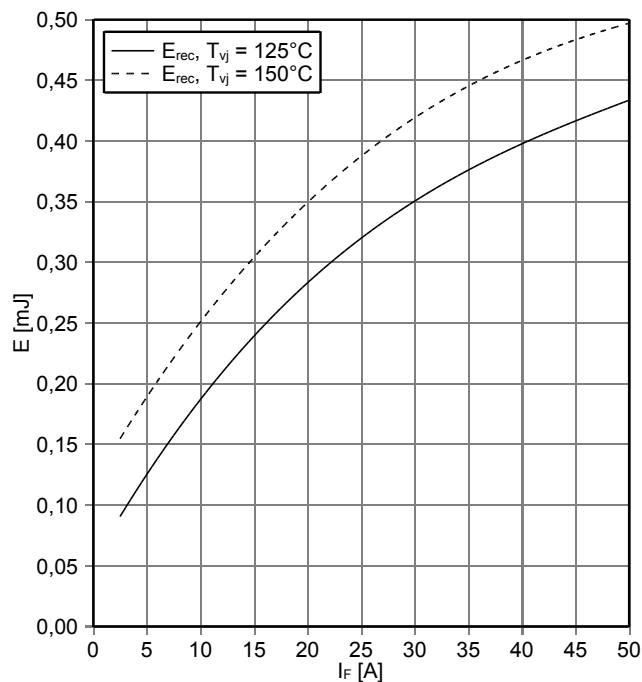
revision: 2.0

暫定データ
Preliminary Data

スイッチング損失 ダイオード, D2 / D3 (Typical)
switching losses Diode, D2 / D3 (typical)

$$E_{rec} = f(I_F)$$

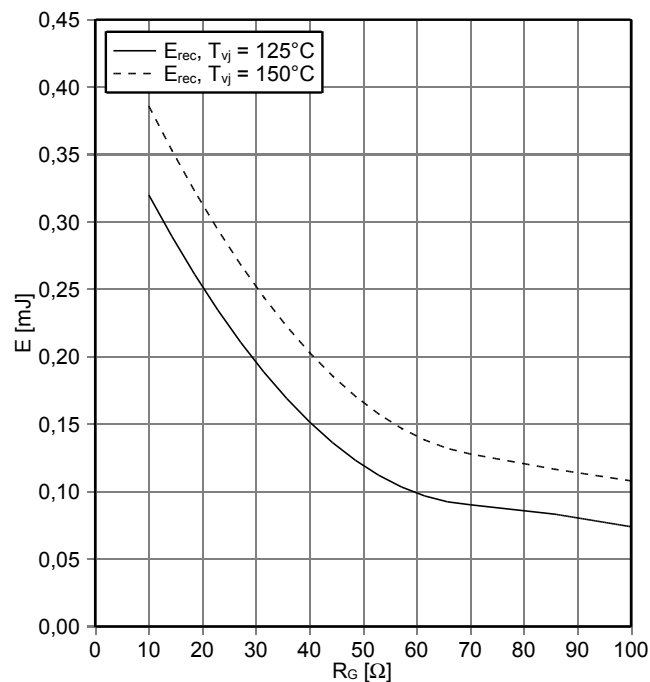
$$R_{Gon} = 10 \Omega, V_{CE} = 350 V$$



スイッチング損失 ダイオード, D2 / D3 (Typical)
switching losses Diode, D2 / D3 (typical)

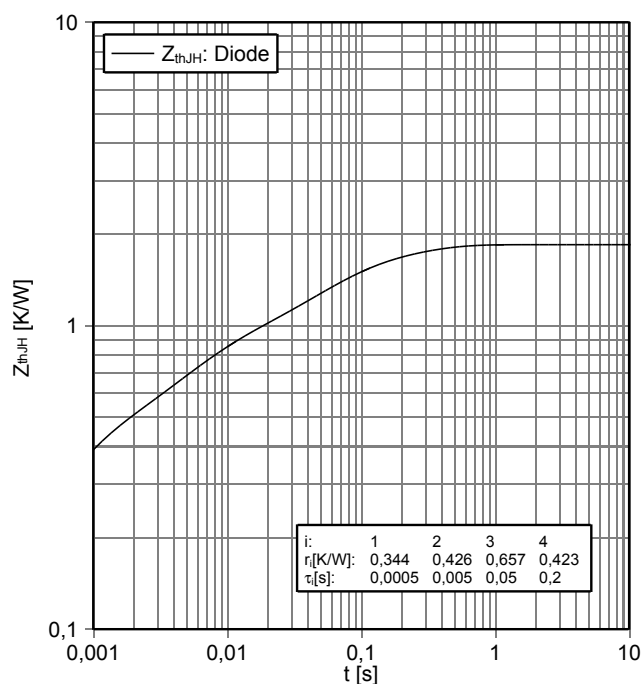
$$E_{rec} = f(R_G)$$

$$I_F = 25 A, V_{CE} = 350 V$$



過渡熱インピーダンス ダイオード, D2 / D3
transient thermal impedance Diode, D2 / D3

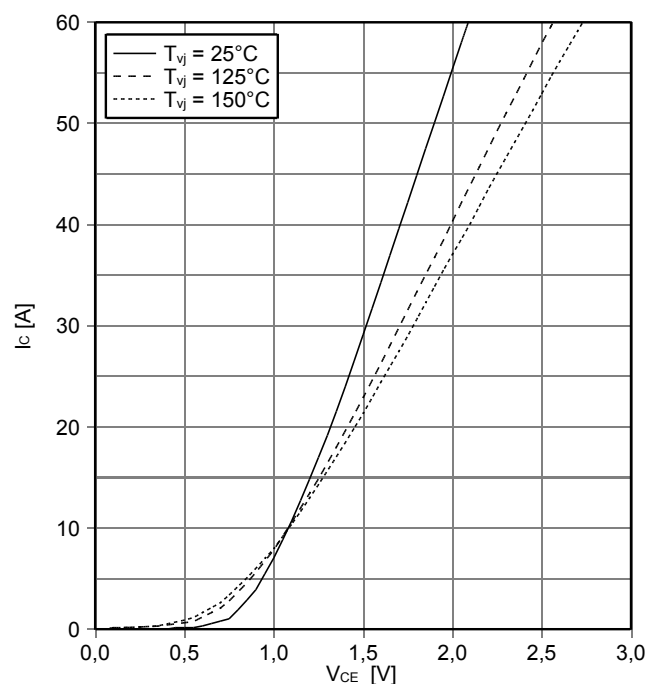
$$Z_{thJH} = f(t)$$



出力特性 IGBT, T2 / T3 (Typical)
output characteristic IGBT, T2 / T3 (typical)

$$I_C = f(V_{CE})$$

$$V_{GE} = 15 V$$



prepared by: CM

date of publication: 2013-11-25

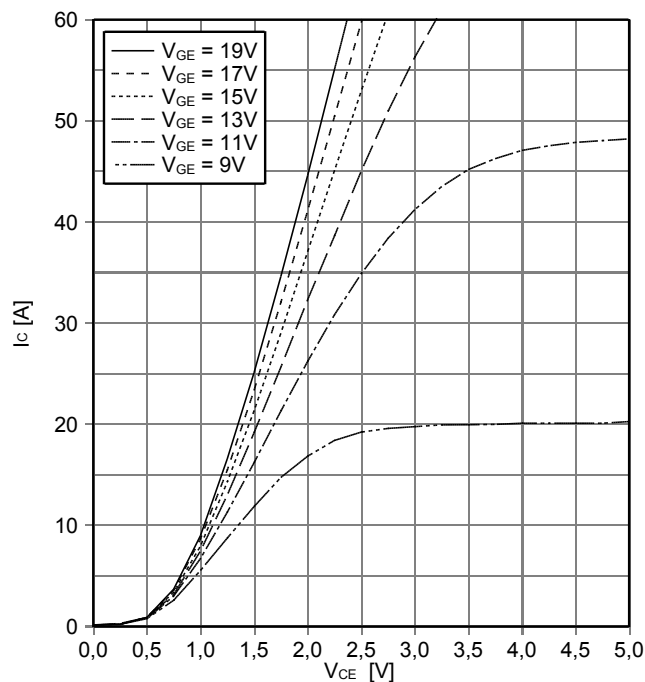
approved by: MB

revision: 2.0

暫定データ
Preliminary Data

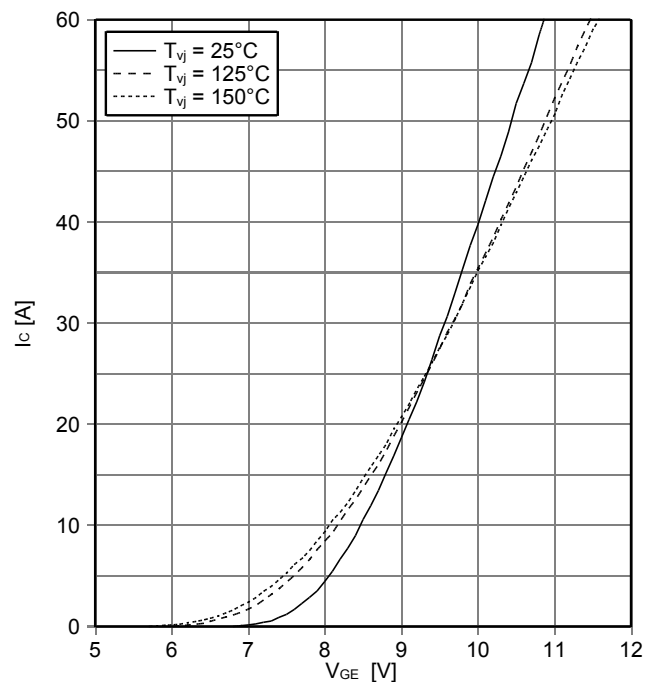
出力特性 IGBT, T2 / T3 (Typical)
output characteristic IGBT, T2 / T3 (typical)

$I_C = f(V_{CE})$
 $T_{vj} = 150^\circ\text{C}$



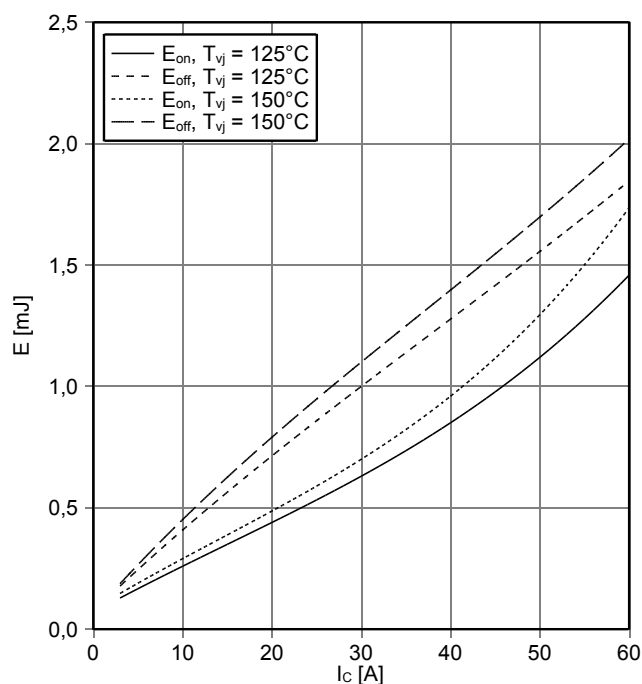
伝達特性 IGBT, T2 / T3 (Typical)
transfer characteristic IGBT, T2 / T3 (typical)

$I_C = f(V_{GE})$
 $V_{CE} = 20\text{ V}$



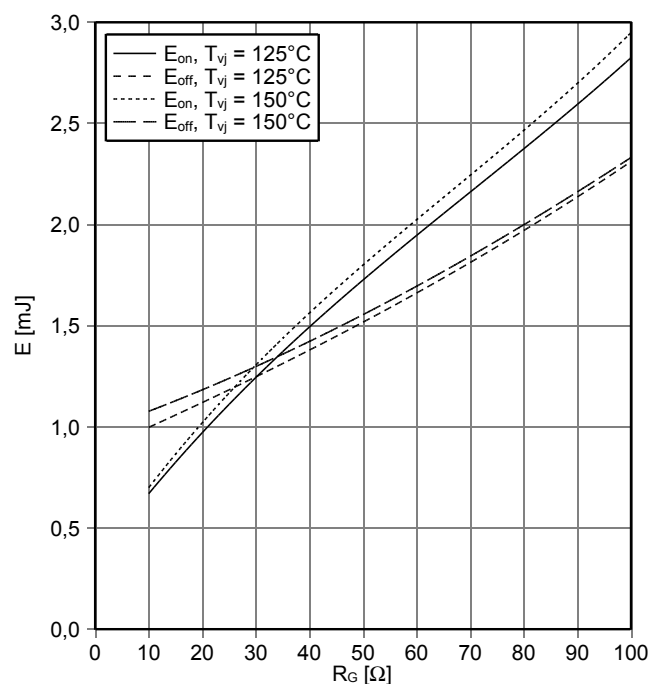
スイッチング損失 IGBT, T2 / T3 (Typical)
switching losses IGBT, T2 / T3 (typical)

$E_{on} = f(I_C)$, $E_{off} = f(I_C)$
 $V_{GE} = \pm 15\text{ V}$, $R_{Gon} = 10\ \Omega$, $R_{Goff} = 10\ \Omega$, $V_{CE} = 350\text{ V}$



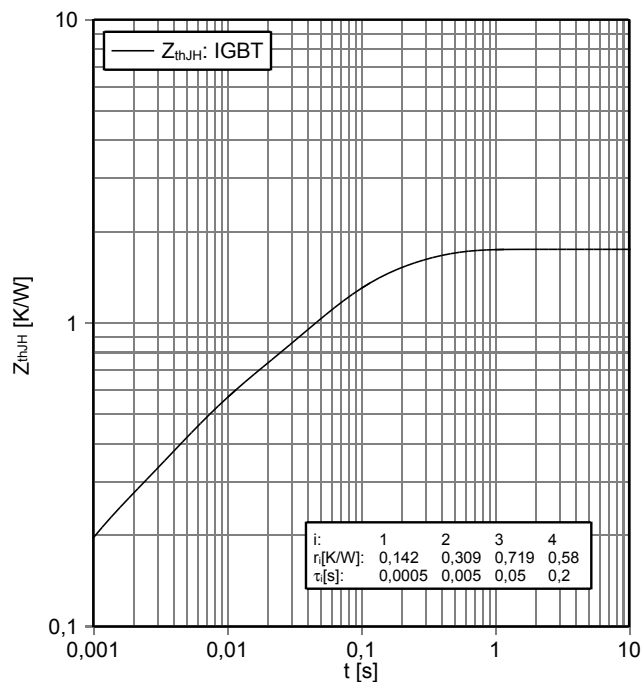
スイッチング損失 IGBT, T2 / T3 (Typical)
switching losses IGBT, T2 / T3 (typical)

$E_{on} = f(R_G)$, $E_{off} = f(R_G)$
 $V_{GE} = \pm 15\text{ V}$, $I_C = 30\text{ A}$, $V_{CE} = 350\text{ V}$

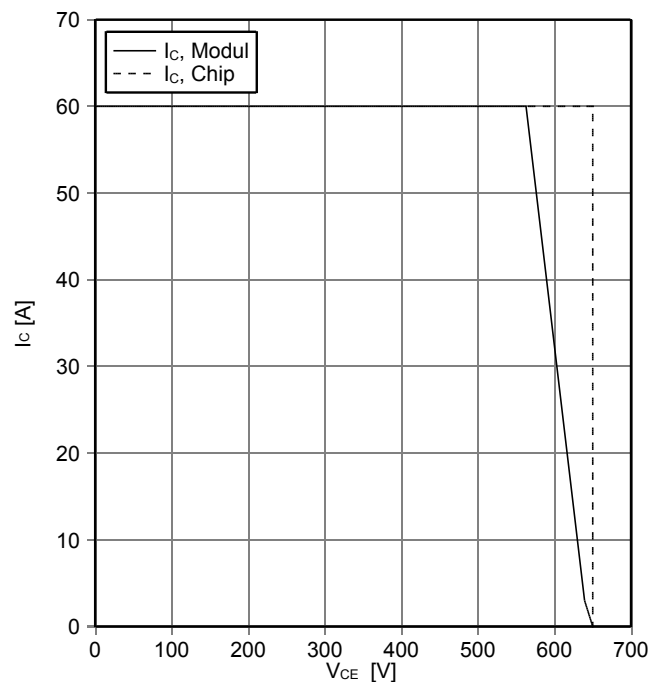


暫定データ
Preliminary Data

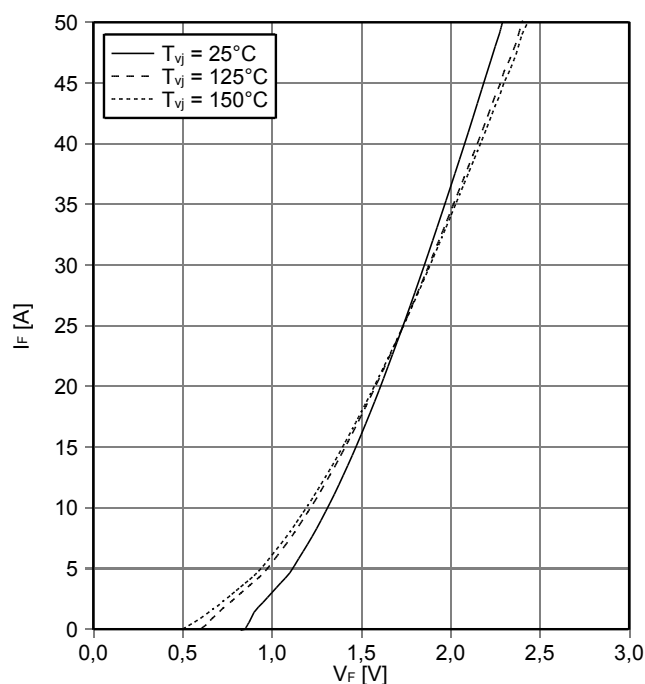
過渡熱インピーダンス IGBT, T2 / T3
transient thermal impedance IGBT, T2 / T3
 $Z_{thJH} = f(t)$



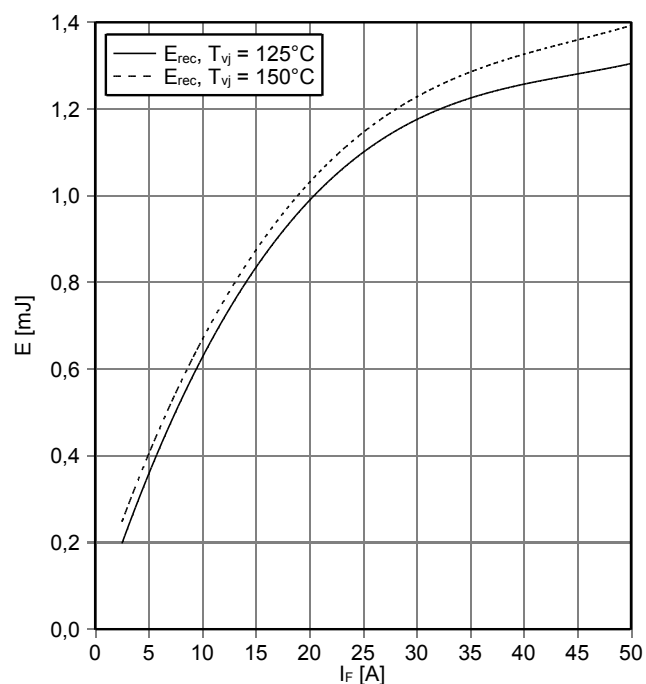
逆バイアス安全動作領域 IGBT, T2 / T3 (RBSOA))
reverse bias safe operating area IGBT, T2 / T3 (RBSOA)
 $I_C = f(V_{CE})$
 $V_{GE} = \pm 15 \text{ V}$, $R_{Goff} = 10 \Omega$, $T_{vj} = 150^\circ\text{C}$



順電圧特性 ダイオード, D1 / D4 (typical)
forward characteristic of Diode, D1 / D4 (typical)
 $I_F = f(V_F)$



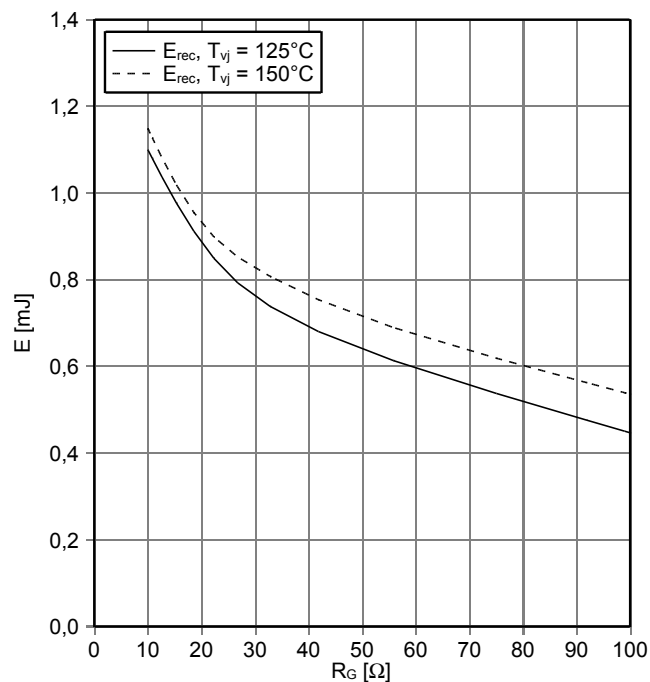
スイッチング損失 ダイオード, D1 / D4 (Typical)
switching losses Diode, D1 / D4 (typical)
 $E_{rec} = f(I_F)$
 $R_{Gon} = 10 \Omega$, $V_{CE} = 350 \text{ V}$



暫定データ
Preliminary Data

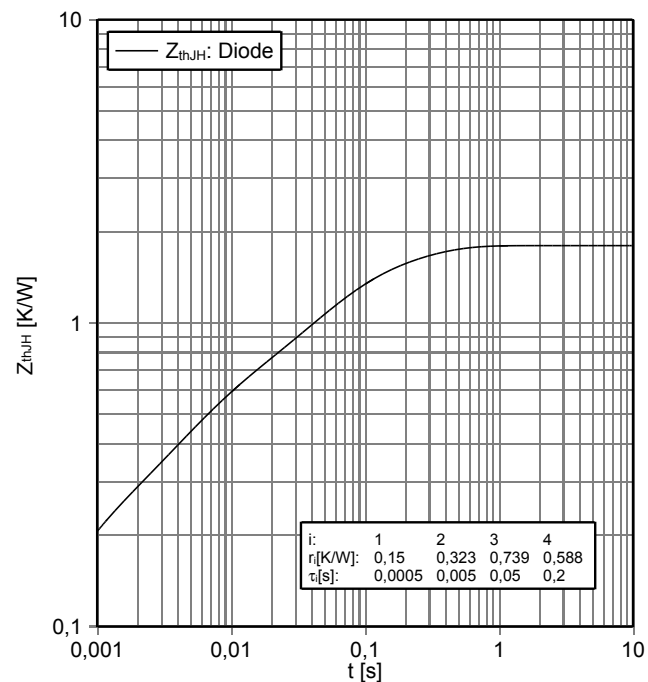
スイッチング損失 ダイオード, D1 / D4 (Typical)
switching losses Diode, D1 / D4 (typical)

$E_{rec} = f(R_G)$
 $I_F = 25\text{ A}$, $V_{CE} = 350\text{ V}$

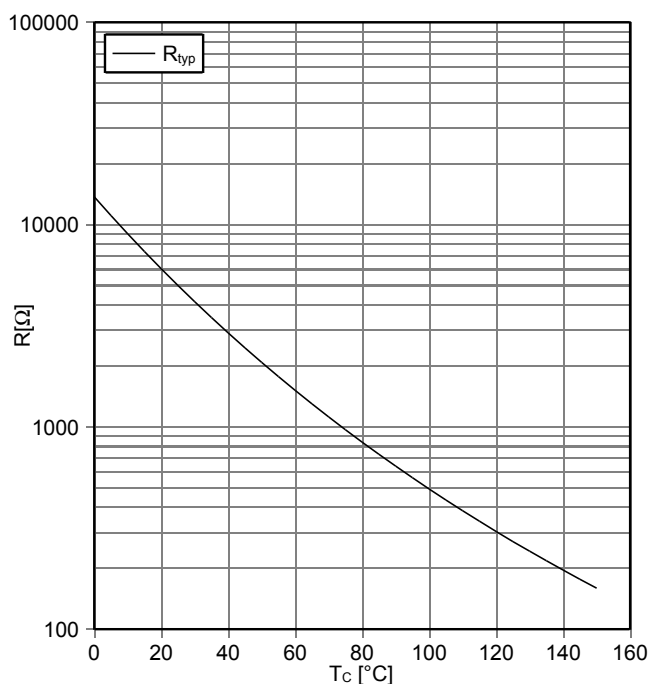


過渡熱インピーダンス ダイオード, D1 / D4
transient thermal impedance Diode, D1 / D4

$Z_{thJH} = f(t)$



NTC-サーミスタ サーミスタの温度特性
NTC-Thermistor-temperature characteristic (typical)
 $R = f(T)$



prepared by: CM	date of publication: 2013-11-25
approved by: MB	revision: 2.0

暫定データ
Preliminary Data

この日本語は、あくまで参考訳となりますので、正式はデータシートに記載されている英文の物となります。

この日本語は、あくまで参考訳となりますので、正式はデータシートに記載されている英文の物となります。

利用規約

このデータシートに記載されているデータ類は、技術者向けの物です。このデバイスを使用される際は、製品が使用されるアプリケーションにて、ご評価頂いた上で、アプリケーションに適切かご判断願います。

このデータシートには、保証されている特性が記述されています。

その他、保証内容は個々の契約期間や条件に応じて決定されます。

保証は、アプリケーションやその特性に対しては行いません。

実際のアプリケーションでの利用に関しては、必ず相当モジュールのアセンブリノートをご確認ください。

追加の技術的情報、アプリケーションでの使用方法について、ご質問がある際には、最寄のセールスオフィスにお問い合わせ願います。(www.infineon.com 参照)

製品にご興味頂き必要があれば、アプリケーションノートを準備させて頂くケースもあります。

技術的な要求によっては、当該製品が危険な物になり得る可能性があります。このようなことが起こる可能性がある場合は、製品を使用される方の責任にて、弊社セールスオフィスに連絡願います。

航空関連、もしくは医療機器や生命維持装置に使用される場合は、インフィニオンと下記の項目を合意しているか、ご確認願います。

- リスク 及び 品質の評価
- 品質契約
- アプリケーションの共同評価

上記の内容の状況に応じて、製品を出荷の判断をさせて頂く場合がございます。

必要に応じて、この規約を関係される方々に送付してください。

インフィニオンはこのデータシートを変更する権利を有します。

Terms & Conditions of usage

The data contained in this product data sheet is exclusively intended for technically trained staff. You and your technical departments will have to evaluate the suitability of the product for the intended application and the completeness of the product data with respect to such application.

This product data sheet is describing the characteristics of this product for which a warranty is granted. Any such warranty is granted exclusively pursuant the terms and conditions of the supply agreement. There will be no guarantee of any kind for the product and its characteristics. The information in the valid application- and assembly notes of the module must be considered.

Should you require product information in excess of the data given in this product data sheet or which concerns the specific application of our product, please contact the sales office, which is responsible for you (see www.infineon.com). For those that are specifically interested we may provide application notes.

Due to technical requirements our product may contain dangerous substances. For information on the types in question please contact the sales office, which is responsible for you.

Should you intend to use the Product in aviation applications, in health or live endangering or life support applications, please notify. Please note, that for any such applications we urgently recommend

- to perform joint Risk and Quality Assessments;
- the conclusion of Quality Agreements;
- to establish joint measures of an ongoing product survey, and that we may make delivery depended on the realization of any such measures.

If and to the extent necessary, please forward equivalent notices to your customers.

Changes of this product data sheet are reserved.

prepared by: CM	date of publication: 2013-11-25
approved by: MB	revision: 2.0